

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和7年4月11日(2025.4.11)

【国際公開番号】WO2024/048414

【出願番号】特願2024-544181(P2024-544181)

【国際特許分類】

H 0 1 G 9/008(2006.01)

H 0 1 G 9/012(2006.01)

H 0 1 G 9/00(2006.01)

H 0 1 G 4/30(2006.01)

10

【F I】

H 0 1 G 9/008303

H 0 1 G 9/012305

H 0 1 G 9/00 290E

H 0 1 G 4/30 201H

【手続補正書】

【提出日】令和7年4月3日(2025.4.3)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

この発明の固体電解コンデンサの製造方法は、コンデンサ素子形成工程と、封止体形成工程と、第1下地電極形成工程と、第3下地電極形成工程と、第1端子電極形成工程と、を有する。コンデンサ素子形成工程においては、弁作用金属を含む平膜状の本体と、陰極形成領域上に形成された誘電体層と、誘電体層上に形成された固体電解質層と、を有し、本体に対して固体電解質層が形成されていない陽極端子領域と、固体電解質層を含む陰極形成領域とを有するコンデンサ素子を形成する。封止体形成工程においては、コンデンサ素子を複数積層し、絶縁性樹脂によって封止され、陽極端子領域の端部が線状に露出する第1端面を有する封止体を形成する。第1下地電極形成工程においては、第1端面に配置され、第1元素を含む第1下地電極を形成する。第3下地電極形成工程においては、第1下地電極の少なくとも一部を覆う、第2元素を含む第3下地電極を形成する。第1端子電極形成工程においては、第3下地電極の少なくとも一部を覆う、第1元素を含む第1端子電極を形成する。

30

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

40

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

弁作用金属を含む平膜状の本体と、陰極形成領域上に形成された誘電体層と、前記誘電体層上に形成された固体電解質層と、を有し、前記本体に対して前記固体電解質層が形成されていない陽極端子領域と、前記固体電解質層を含む前記陰極形成領域とを有するコンデンサ素子を形成するコンデンサ素子形成工程と、

前記コンデンサ素子を複数積層し、絶縁性樹脂によって封止され、前記陽極端子領域の端部が線状に露出する第1端面を有する封止体を形成する封止体形成工程と、

前記第1端面に配置され、第1元素を含む第1下地電極を形成する第1下地電極形成工

50

程と、

前記第1下地電極の少なくとも一部を覆う、第2元素を含む第3下地電極を形成する第3下地電極形成工程と、

前記第3下地電極の少なくとも一部を覆う、前記第1元素を含む第1端子電極を形成する第1端子電極形成工程と、

を有し、

前記第3下地電極が形成された前記第1端面に前記第1端子電極を加熱しながら押し当てることにより、前記第1下地電極と前記第3下地電極とを反応させて、かつ前記第1端子電極と前記第3下地電極とを反応させて、前記第1元素と前記第2元素とを含む第2下地電極を形成する、固体電解コンデンサの製造方法。

10

20

30

40

50